

半導体ニュース No.781E とさしかえてください。

2SA1208/2SC2910 — PNP/NPNエピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ 高電圧スイッチング オーディオ80W出力プリドライバ用

- 特長
- ・FBETプロセス採用。
 - ・高耐圧である。
 - ・ h_{FE} のリニアリティが良く、 c_{ob} が小さい。
 - ・スイッチングタイムが速い。

()内は、2SA1208の場合を示す。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	(-)180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	(-)160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	(-)5	V
コレクタ電流	I_C	(-)70	mA
ピークコレクタ電流	i_{cp}	(-)140	mA
コレクタ損失	P_C	900	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。

本書記載製品が、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物資(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。

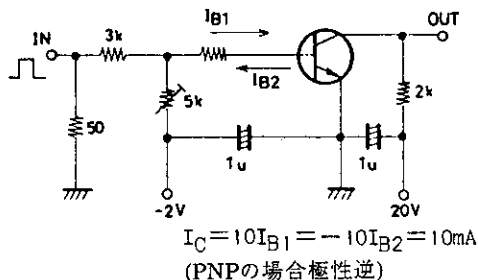
電気的特性 Electrical Characteristics / $T_a = 25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = (-)80\text{V}, I_E = 0$			(-)0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = (-)4\text{V}, I_C = 0$			(-)0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)10\text{mA}$	100 ※		400 ※	
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = (-)10\text{V}, I_C = (-)10\text{mA}$		150		MHz
出力容量	c_{ob}	$V_{CB} = (-)10\text{V}, f = 1\text{MHz}$		(2.5)2.0		pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = (-)30\text{mA}, I_B = (-)3\text{mA}$		(-0.14)	(-0.4)	V
				0.08	0.3	V
ターンオン時間	t_{on}	下図指定測定回路において		0.1		μsec
下降時間	t_f	〃		0.2		μsec
蓄積時間	t_{stg}	〃		1.0		μsec

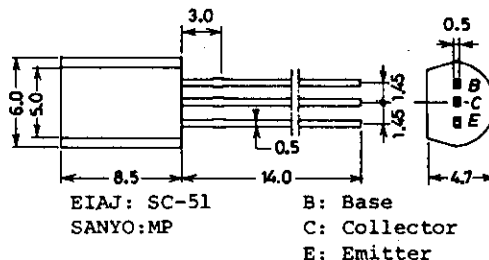
※2SA1208/2SC2910は10mA h_{FE} により次のように分類している。

100 R	200	140 S	280	200 T	400
-------	-----	-------	-----	-------	-----

スイッチングタイム測定回路



外形図 2006A
(unit: mm)



45050

※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田180

三洋電機株式会社 半導体事業本部

